

# 2SD888

## シリコン NPN 三重拡散プレーナ形 / Si NPN Triple Diffused Planar

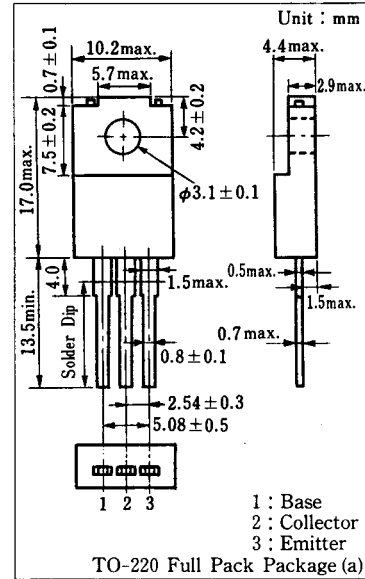
高電流増幅率, 低周波電力増幅用 / High  $h_{FE}$ , AF Power Amplifier

### ■ 特徴 / Features

- コレクタ・エミッタ飽和電圧  $V_{CE(sat)}$  が低い。 / Low  $V_{CE(sat)}$
- スイッチング速度が速い。 / High speed switching
- 放熱板への取付けがビス1本で可能な“フルパック”パッケージ。  
“Full Pack” package for simplified mounting only by a screw, requires no insulator.

### ■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	100	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	60	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	7	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	12	A
コレクタ電流	$I_C$	6	A
ベース電流	$I_B$	3	A
コレクタ損失	$T_c=25^\circ\text{C}$	50	W
	$T_a=25^\circ\text{C}$	2	
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



### ■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=100\text{ V}, I_E=0$			100	$\mu\text{A}$
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=7\text{ V}, I_C=0$			100	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$I_C=25\text{ mA}, I_B=0$	60			V
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=4\text{ V}, I_C=1\text{ A}$	300		2000	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5\text{ A}, I_B=0.1\text{ A}$			1	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE}=12\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$		30		MHz
蓄積時間	$t_{stg}$	$I_C=5\text{ A}, I_{B1}=0.1\text{ A}, I_{B2}=-0.1\text{ A}$		2.1		$\mu\text{s}$
下降時間	$t_f$			0.7		$\mu\text{s}$

### \* $h_{FE}$ ランク分類 / $h_{FE}$ Classifications

Class	Q	P
$h_{FE}$	300 ~ 1200	800 ~ 2000